



	<h2 style="color: #D9534F;">SIHU3N50D-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SIHU3N50D-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 3A TO251 IPAK
	Datenblätter: <ul style="list-style-type: none">  1.SIHU3N50D-GE3.pdf  2.SIHU3N50D-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	




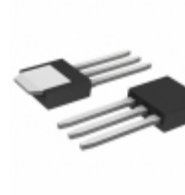

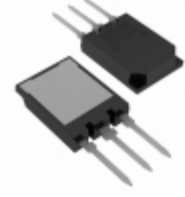


Spezifikationen

Teilenummer	SIHU3N50D-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 3A TO251 IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-251
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.2 Ohm @ 2.5A, 10V
Verlustleistung (max)	69W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	18 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	175pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 3A (Tc) 69W (Tc) Through Hole TO-251
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3A (Tc)

SIHU3N50D-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHU3N50D-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHU3N50D-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIHU3N50D-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIHU3N50D-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 3A TO251 IPAK</p>	 <p>SIHU5N50D-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 5.3A TO251 IPAK</p>	 <p>SIHU3N50DA-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHANNEL 500V 3A IPAK</p>	 <p>SIHU4N80E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 800V TO-251 IPAK</p>
 <p>SIHU2N80E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 2.8A IPAK</p>	 <p>SIHS90N65E-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 87A SUPER247</p>	 <p>SIHU5N50D-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 5.3A TO251 IPAK</p>	 <p>SIHU3N50D-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 3A TO251 IPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHU3N50D-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIHU3N50D-GE3 Datenblatt	SIHU3N50D-GE3-Datenblätter	SIHU3N50D-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIHU3N50D-GE3
SIHU3N50D-GE3 Electronic	SIHU3N50D-GE3-Komponenten	SIHU3N50D-GE3-Verteiler	SIHU3N50D-GE3-Bild	SIHU3N50D-GE3-Teil
SIHU3N50D-GE3 Preis	SIHU3N50D-GE3 Hersteller	SIHU3N50D-GE3 Bild	SIHU3N50D-GE3 Aktie	SIHU3N50D-GE3 Inventar
SIHU3N50D-GE3 Neu	SIHU3N50D-GE3 Original	SIHU3N50D-GE3 garantiert	SIHU3N50D-GE3 RFQ	SIHU3N50D-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited